

**TRANSLATION OF AN OFFICIAL ACTION**

**Notice of Grounds for Rejection**

Dispatch No.: 067993  
Dispatch Date: March 1, 2005  
Patent Application, No.: 9-264481  
Date: February 22, 2005  
Patent Office Examiner: Hirosuke Minami, (9306 2M00)  
Agent of Applicant: Masashi Yanagida (and 1  
other)  
Article of Law Applied: Article 29, Paragraph 2

This application is rejected on the grounds described hereunder. If there are any comments, please file an argument within three months of the dispatch date.

**Grounds**

The invention in the claim listed below of the subject application should not be granted a patent under the provision of Patent Law Section 29(2) since it could have easily been made by persons who have common knowledge in the technical field to which the invention pertains, on the basis of the inventions described in the publications listed below which were distributed in Japan or foreign countries prior to the filing of the subject application.

**Notes** (refer to the list of cited references)

- Claim 1
- Cited References 1-3
- Remark

Cited References 1 to 3 describe two-dimensional matrix type light modulation and light emitting devices comprising a drive circuit that is constituted by a ferroelectric substance gate FET having a ferroelectric substance between a gate electrode and a semiconductor.

For two-dimensional matrix type light modulation and light emitting devices applied to liquid crystal display devices, see Cited Reference 1 and Cited Reference 3 (paragraph [0026]). For those applied to thin film EL light emitters, see Cited Reference 2.

#### List of Cited References

1. Japanese Unexamined Patent Publication No. 3 (1991)-022483
2. Japanese Unexamined Patent Publication No. 60(1985)-091597
3. Japanese Unexamined Patent Publication No. 8(1996)-306806

## 拒絶理由通知書

特許出願の番号 平成 9年 特許願 第264481号  
起案日 平成17年 2月22日  
特許庁審査官 南 宏輔 9306 2M00  
特許出願人代理人 柳田 征史(外 1名) 様  
適用条文 第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

## 理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項1
- ・引用文献等1-3
- ・備考

2次元アクティブマトリクス型の光変調素子又は発光素子において、ゲート電極と半導体の間に強誘電体を形成した強誘電体ゲートFETにより構成される駆動回路を備えたものが、引用例1-3のそれぞれに記載されている。

液晶表示装置に適用したものは引用例1, 引用例3(【0026】参照)を、薄膜EL発光装置に適用したものは引用例2を参照。

## 引 用 文 献 等 一 覧

1. 特開平03-022483号公報
2. 特開昭60-091597号公報
3. 特開平08-306806号公報

## 先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 IPC第7版 G09F 9/00-46

G O 2 F 1 / 1 3 3

G O 2 F 1 / 1 3 4 3 - 1 3 6 8

H O 1 L 2 9 / 7 8

H O 5 B 3 3 / 0 0 - 2 8

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知書の内容に関する問合せ先

特許審査第一部 ナノ光学 南 宏輔

Tel 3581-1101(ex. 3274) Fax 3592-8858